

а 2002 0071

Изобретение относится к технологии полупроводников и может быть использовано в электронике и энергетике.

Способ получения полисульфидных пленок включает обрабатывание соединений $Zn_xIn_2S_{3+x}$ ($x=1, 2, 3, 5$) с раствором $ZnCl_2$, осаждение на подложку, предварительно обработанную в растворе $ZnCl_2$, с последующим высушиванием при температуре 373 К и термической обработке $T \cdot t$ $(6,3-8,5)10^3$ град·час (где T и t – температура и время обработки соответственно).

П. формулы: 1